

## DS18B20 单线数字温度传感器

### 新的“一线器件” DS18B20 体积更小、适用电压更宽、更经济

Dallas 半导体公司的数字化温度传感器 DS1820 是世界上第一片支持“一线总线”接口的温度传感器。一线总线独特而且经济的特点，使用户可轻松地组建传感器网络，为测量系统的构建引入全新概念。现在，新一代的“DS18B20”体积更小、更经济、更灵活。使您可以充分发挥“一线总线”的长处。

### DS18B20、DS1822 “一线总线”数字化温度传感器

同 DS1820 一样，DS18B20 也支持“一线总线”接口，测量温度范围为  $-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$ ，在  $-10^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$  范围内，精度为  $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 。DS1822 的精度较差为  $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 。现场温度直接以“一线总线”的数字方式传输，大大提高了系统的抗干扰性。适合于恶劣环境的现场温度测量，如：环境控制、设备或过程控制、测温类消费电子产品等。

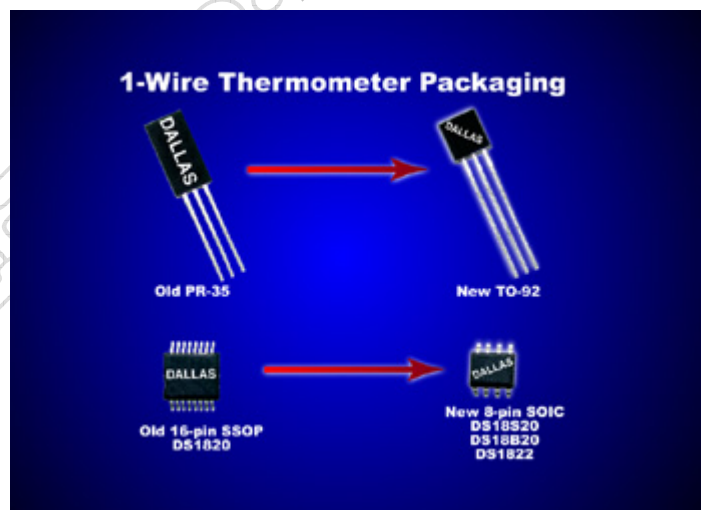
与前一代产品不同，新的产品支持  $3\text{V}\sim 5.5\text{V}$  的电压范围，使系统设计更灵活、方便。而且新一代产品更便宜，体积更小。

### DS18B20、DS1822 的特性

DS18B20 可以程序设定  $9\sim 12$  位的分辨率，精度为  $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 。可选更小的封装方式，更宽的电压适用范围。分辨率设定，及用户设定的报警温度存储在 EEPROM 中，掉电后依然保存。DS18B20 的性能是新一代产品中最好的！性能价格比也非常出色！

DS1822 与 DS18B20 软件兼容，是 DS18B20 的简化版本。省略了存储用户定义报警温度、分辨率参数的 EEPROM，精度降低为  $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ，适用于对性能要求不高，成本控制严格的应用，是经济型产品。

继“一线总线”的早期产品后，DS1820 开辟了温度传感器技术的新概念。DS18B20 和 DS1822 使电压、特性及封装有更多的选择，让我们可以构建适合自己的经济的测温系统。



### DS18B20 新特点:

适用电压为  $3\text{V}\sim 5\text{V}$

与 DS1820 软件略有不同

$9\sim 12$  位分辨率可调

TO-92、SOIC 及 CSP 封装可选，经济型版本无 EEPROM 合自己的经济的测温系统。

### DS18xx 传统特性:

测温范围  $-55^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$

$-10^{\circ}\text{C}$  to  $+85^{\circ}\text{C}$  范围内  $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$  , (DS1822 除外)

用户可定义的 EEPROM, 设定的报警温度存在非易失存储器中 (DS1822 除外)

无需外部元件

### “一线总线”特征:

独特的电源和信号复合在一起

仅使用一条口线

每个芯片唯一编码, 支持联网寻址

简单的网络化的温度感知

零功耗等待

### DS18xx 产品性能对照表

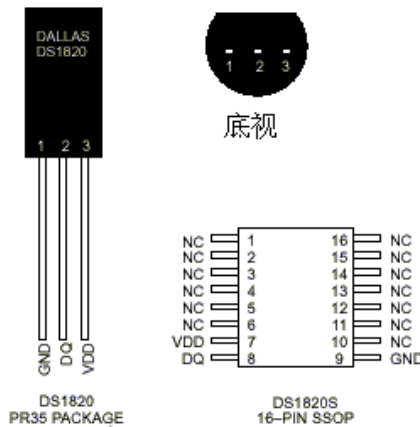
型号	工作电压	分辨率	精度	EEPROM	软件兼容性	封装	采集模块
DS1820	4.3~5.5V	> 9 位	$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$	有	第一代产品	SSOP, PR-35	LTM-8000 系列
DS18B20	3.0~5.5V	9 ~12 位	$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$	有	与DS1820 部分兼容	SOIC, T0-92	LTM-8000 系列
DS1822	3.0~5.5V	9 ~12 位	$\pm 2^{\circ}\text{C}$	无	同 DS18B20	SOIC, T0-92	LTM-8000 系列

### 以下为 DS1820 的详细应用说明

#### 特性

- 独特的单线接口仅需一个端口引脚进行通讯
- 简单的多点分布应用
- 无需外部器件
- 可通过数据线供电
- 零待机功耗
- 测温范围  $-55 \sim +125^{\circ}\text{C}$ , 以  $0.5^{\circ}\text{C}$  递增。华氏器件  $-67 \sim +257^{\circ}\text{F}$ , 以  $0.9^{\circ}\text{F}$  递增
- 温度以 9 位数字量读出
- 温度数字量转换时间 200ms (典型值)
- 用户可定义的非易失性温度报警设置
- 报警搜索命令识别并标志超过程序限定温度 (温度报警条件) 的器件
- 应用包括温度控制、工业系统、消费品、温度计或任何热感测系统

引脚排列



引脚说明

- GND - 地
- DQ - 数据I/O
- V<sub>DD</sub> - 可选VDD
- NC - 空脚

说明

DS1820 数字温度计以 9 位数字量的形式反映器件的温度值。

DS1820 通过一个单线接口发送或接收信息，因此在中央微处理器和 DS1820 之间仅需一条连接线（加上地线）。用于读写和温度转换的电源可以从数据线本身获得，无需外部电源。

因为每个 DS1820 都有一个独特的片序列号，所以多只 DS1820 可以同时连在一根单线总线上，这样就可以把温度传感器放在许多不同的地方。这一特性在 HVAC 环境控制、探测建筑物、仪器或机器的温度以及过程监测和控制等方面非常有用。

引脚说明

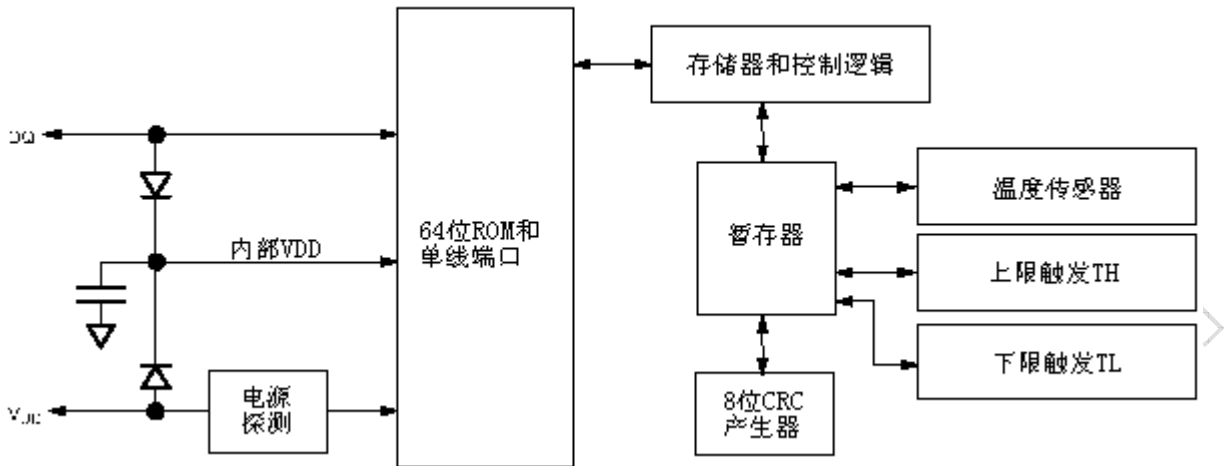
16 脚 SSOP	PR35	符号	说明
9	1	GND	接地
8	2	DQ	数据输入/输出脚。对于单线操作：漏极开路（见“寄生电源”节）
7	3	VDD	可选的 VDD 引脚。具体接法见“寄生电源”节

DS1820S（16 脚 SSOP）：所有上表中未提及的引脚都无连接。

概览

图 1 的方框图示出了 DS1820 的主要部件。DS1820 有三个主要数字部件：1) 64 位激光 ROM，2) 温度传感器，3) 非易失性温度报警触发器 TH 和 TL。器件用如下方式从单线通讯线上汲取能量：在信号线处于高电平期间把能量储存在内部电容里，在信号线处于低电平期间消耗电容上的电能工作，直到高电平到来再给寄生电源（电容）充电。DS1820 也可用外部 5V 电源供电。

DS1820方框图 (图1)



DS1820 依靠一个单线端口通讯。在单线端口条件下，必须先建立 ROM 操作协议，才能进行存储器和控制操作。因此，控制器必须首先提供下面 5 个 ROM 操作命令之一：1) 读 ROM，2) 匹配 ROM，3) 搜索 ROM，4) 跳过 ROM，5) 报警搜索。这些命令对每个器件的激光 ROM 部分进行操作，在单线总线上挂有多个器件时，可以区分出单个器件，同时可以向总线控制器指明有多少器件或是什么型号的器件。成功执行完一条 ROM 操作序列后，即可进行存储器和控制操作，控制器可以提供 6 条存储器和控制操作指令中的任一条。

一条控制操作命令指示 DS1820 完成一次温度测量。测量结果放在 DS1820 的暂存器里，用一条读暂存器内容的存储器操作命令可以把暂存器中数据读出。温度报警触发器 TH 和 TL 各由一个 EEPROM 字节构成。如果没有对 DS1820 使用报警搜索命令，这些寄存器可以做为一般用途的用户存储器使用。可以用一条存储器操作命令对 TH 和 TL 进行写入，对这些寄存器的读出需要通过暂存器。所有数据都是以最低有效位在前的方式进行读写。

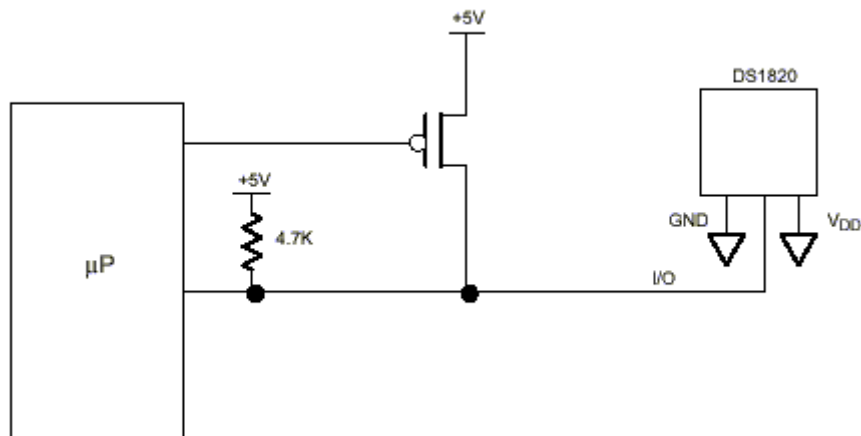
寄生电源

寄生电源的方框图见图 1。这个电路会在 I/O 或 VDD 引脚处于高电平时“偷”能量。当有特定的时间和电压需求时（见节标题“单线总线系统”），I/O 要提供足够的能量。寄生电源有两个好处：1) 进行远距离测温时，无需本地电源，2) 可以在没有常规电源的条件下读 ROM。

要想使 DS1820 能够进行精确的温度转换，I/O 线必须在转换期间保证供电。由于 DS1820 的工作电流达到 1mA，所以仅靠 5K 上拉电阻提供电源是不行的，当几只 DS1820 挂在同一根 I/O 线上并同时想进行温度转换时，这个问题变得更加尖锐。

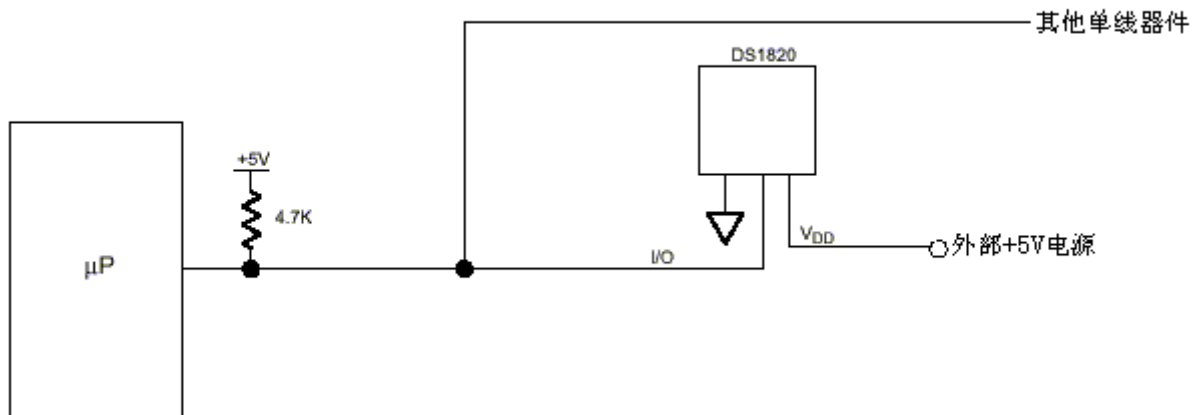
有两种方法能够使 DS1820 在动态转换周期中获得足够的电流供应。第一种方法，当进行温度转换或拷贝到 E<sup>2</sup> 存储器操作时，给 I/O 线提供一个强上拉。用 MOSFET 把 I/O 线直接拉到电源上就可以实现，见图 2。在发出任何涉及拷贝到 E<sup>2</sup> 存储器或启动温度转换的协议之后，必须在最多 10 μs 之内把 I/O 线转换到强上拉。使用寄生电源方式时，VDD 引脚必须接地。

DS1820温度转换期间的强上拉供电 (图2)



另一种给 DS18B20 供电的方法是从 VDD 引脚接入一个外部电源，见图 3。这样做的好处是 I/O 线上不需要加强上拉，而且总线控制器不用在温度转换期间总保持高电平。这样在转换期间可以允许在单线总线上进行其他数据往来。另外，在单线总线上可以挂任意多片 DS18B20，而且如果它们都使用外部电源的话，就可以先发一个 Skip ROM 命令，再接一个 Convert T 命令，让它们同时进行温度转换。注意当加上外部电源时，GND 引脚不能悬空。

用VDD供电（图3）



温度高于 100℃时，不推荐使用寄生电源，因为 DS18B20 在这种温度下表现出的漏电流比较大，通讯可能无法进行。在类似这种温度的情况下，强烈推荐使用 DS18B20 的 VDD 引脚。

对于总线控制器不知道总线上的 DS18B20 是用寄生电源还是用外部电源的情况，DS18B20 预备了一种信号指示电源的使用意图。总线控制器发出一个 Skip ROM 协议，然后发出读电源命令，这条命令发出后，控制器发出读时间隙，如果是寄生电源，DS18B20 在单线总线上发回“0”，如果是从 VDD 供电，则发回“1”，这样总线控制器就能够决定总线上是否有 DS18B20 需要强上拉。如果控制器接收到一个“0”，它就知道必须在温度转换期间给 I/O 线提供强上拉。这个命令协议详见“存储器操作命令”节。

测温操作

DS18B20 通过一种片上温度测量技术来测量温度。图 4 示出了温度测量电路的方框图。

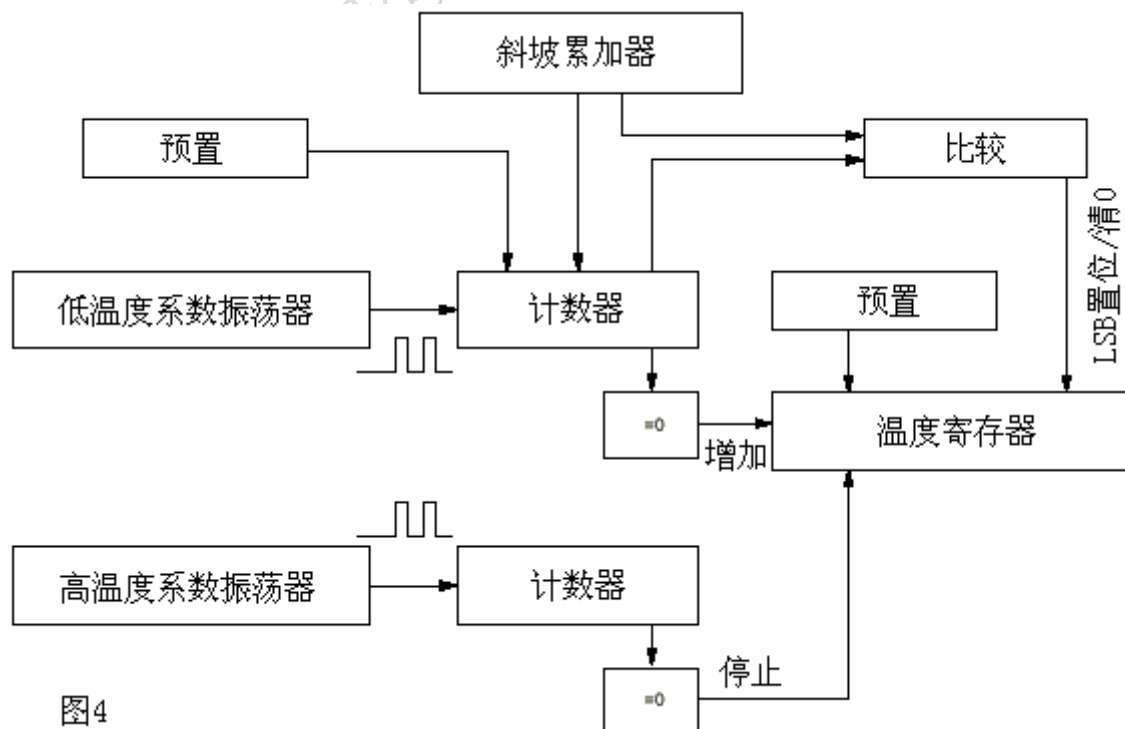


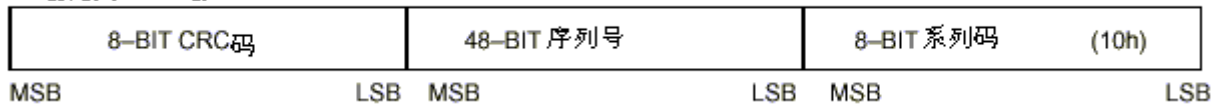
图4

温度/数据关系（表1）



ROM, 5) Alarm Search。成功进行一次 ROM 操作后, 就可以对 DS1820 进行特定的操作, 总线控制器可以发出六个存储器和控制操作命令中的任一个。

64位光刻ROM (图5)



#### CRC 发生器

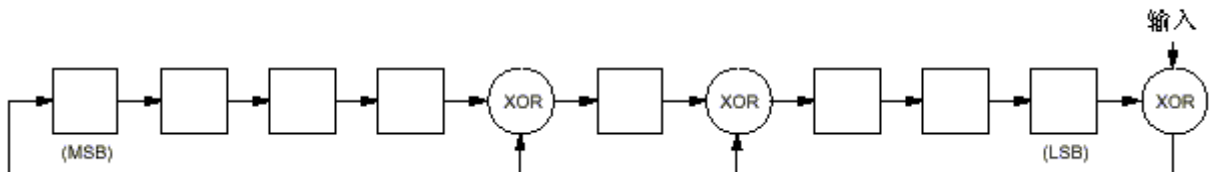
DS1820 中有 8 位 CRC 存储在 64 位 ROM 的最高有效字节中。总线控制器可以用 64 位 ROM 中的前 56 位计算出一个 CRC 值, 再用这个和存储在 DS1820 中的值进行比较, 以确定 ROM 数据是否被总线控制器接收无误。CRC 计算等式如下:

$$CRC = X^8 + X^5 + X^4 + 1$$

DS1820 同样用上面的公式产生一个 8 位 CRC 值, 把这个值提供给总线控制器用来校验传输的数据。在任何使用 CRC 进行数据传输校验的情况下, 总线控制器必须用上面的公式计算出一个 CRC 值, 和存储在 DS1820 的 64 位 ROM 中的值或 DS1820 内部计算出的 8 位 CRC 值 (当读暂存器时, 做为第 9 个字节读出来) 进行比较。CRC 值的比较以及是否进行下一步操作完全由总线控制器决定。当在 DS1820 中存储的或由其计算的 CRC 值和总线控制器计算的值不相符时, DS1820 内部并没有一个能阻止命令序列进行的电路。

单线 CRC 可以用一个由移位寄存器和 XOR 门构成的多项式发生器来产生, 见图 7。

单线CRC码 (图7)

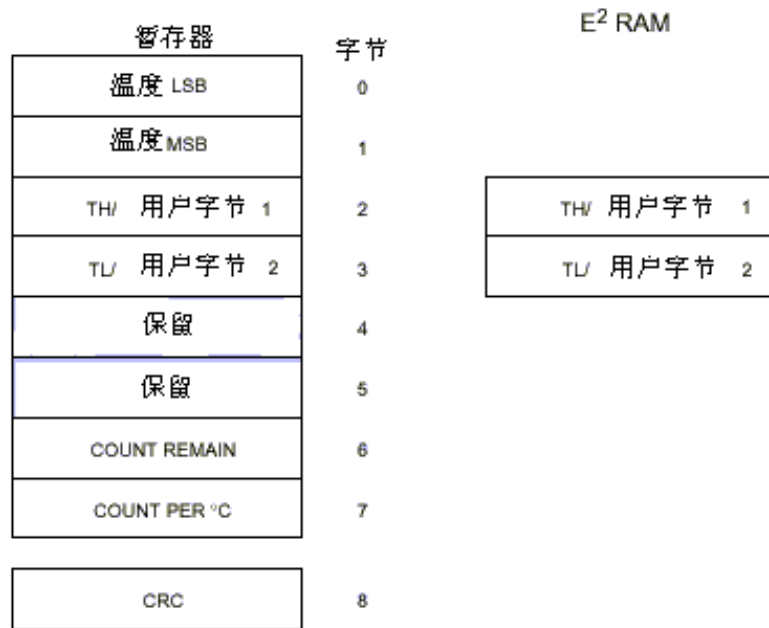


移位寄存器的各位都被初始化为 0。然后从系列编号的最低有效位开始, 一次一位移入寄存器, 8 位系列编码都进入以后, 序列号再进入, 48 位序列号都进入后, 移位寄存器中就存储了 CRC 值。移入 8 位 CRC 会使移位寄存器复 0。

#### 存储器

DS1820 的存储器结构示于图 8。存储器由一个暂存 RAM 和一个存储高低温报警触发值 TH 和 TL 的非易失性电可擦除 (E<sup>2</sup>) RAM 组成。当在单线总线上通讯时, 暂存器帮助确保数据的完整性。数据先被写入暂存器, 这里的数据可被读回。数据经过校验后, 用一个拷贝暂存器命令会把数据传到非易性 (E<sup>2</sup>) RAM 中。这一过程确保更改存储器时数据的完整性。

DS18B20存储器图 (图8)



寄存器的结构为 8 个字节的存储器。头两个字节包含测得的温度信息。第三和第四字节是 TH 和 TL 的拷贝，是易失性的，每次上电复位时被刷新。下面两个字节没有使用，但是在读回数据时，它们全部表现为逻辑 1。第七和第八字节是计数寄存器，它们可以被用来获得更高的温度分辨力（见“测温操作”一节）。

还有一个第九字节，可以用读暂存器命令读出。这个字节是以上八个字节的 CRC 码。CRC 的执行方式如第二个标题“CRC 发生器”所述。

#### 单线总线系统

单线总线系统包括一个总线控制器和一个或多个从机。DS18B20 是从机。关于这种总线分三个题目讨论：硬件结构、执行序列和单线信号（信号类型和时序）。

单线总线只有一条定义的信号线；重要的是每一个挂在总线上的器件都能在适当的时间驱动它。为此每一个总线上的器件都必须是漏极开路或三态输出。DS18B20 的单总线端口（I/O 引脚）是漏极开路式的，内部等效电路见图 9。一个多点总线由一个单线总线和多个挂于其上的从机构成。单线总线需要一个约 5K Ω 的上拉电阻。

硬件结构 (图9)



单线总线的空闲状态是高电平。无论任何理由需要暂停某一执行过程时，如果还想恢复执行的话，总线必须停留在空闲状态。在恢复期间，如果单线总线处于非活动（高电平）状态，位与位间的恢复时间可以无限长。如果总线停留在低电平超过 480 µs，总线上的所有器件都将被复位。

#### 执行序列

通过单线总线端口访问 DS18B20 的协议如下：



- 初始化
- ROM 操作命令
- 存储器操作命令
- 执行/数据

#### 初始化

通过单线总线的所有执行（处理）都从一个初始化序列开始。初始化序列包括一个由总线控制器发出的复位脉冲和跟有其后由从机发出的存在脉冲。

存在脉冲让总线控制器知道 DS1820 在总线上且已准备好操作。详见“单线信号”节。

#### ROM 操作命令

一旦总线控制器探测到一个存在脉冲，它就可以发出 5 个 ROM 命令中的任一个。所有 ROM 操作命令都 8 位长度。下面是这些命令（参见图 6 流程图）：

#### ROM 操作流程图（图 6）

#### Read ROM [33h]

这个命令允许总线控制器读到 DS1820 的 8 位系列编码、唯一的序列号和 8 位 CRC 码。只有在总线上存在单只 DS1820 的时候才能使用这个命令。如果总线上不止一个从机，当所有从机试图同时传送信号时就会发生数据冲突（漏极开路连在一起开成相与的效果）。

#### Match ROM [55h]

匹配 ROM 命令，后跟 64 位 ROM 序列，让总线控制器在多点总线上定位一只特定的 DS1820。只有和 64 位 ROM 序列完全匹配的 DS1820 才能响应随后的存储器操作命令。所有和 64 位 ROM 序列不匹配的从机都将等待复位脉冲。这条命令在总线上有单个或多个器件时都可以使用。

#### Skip ROM [CCh]

这条命令允许总线控制器不用提供 64 位 ROM 编码就使用存储器操作命令，在单点总线情况下可以节省时间。如果总线上不止一个从机，在 Skip ROM 命令之后跟着发一条读命令，由于多个从机同时传送信号，总线上就会发生数据冲突（漏极开路下拉效果相当于相与）。

#### Search ROM [F0h]

当一个系统初次启动时，总线控制器可能并不知道单线总线上有多少器件或它们的 64 位 ROM 编码。搜索 ROM 命令允许总线控制器用排除法识别总线上的所有从机的 64 位编码。

#### Alarm Search [ECh]

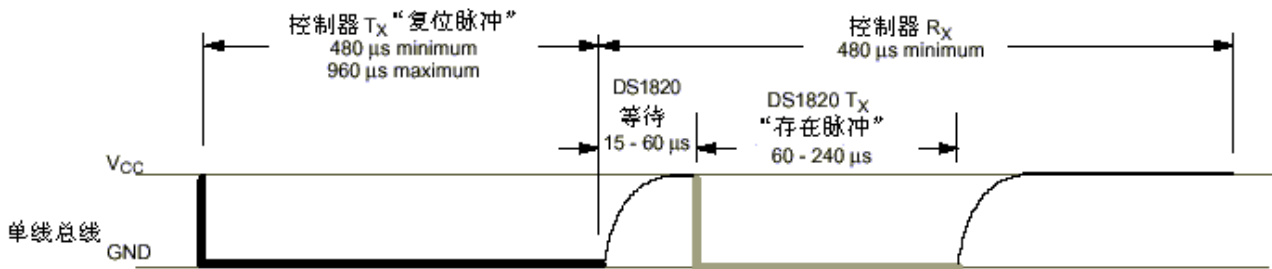
这条命令的流程图和 Search ROM 相同。然而，只有在最近一次测温后遇到符合报警条件的情况，DS1820 才会响应这条命令。报警条件定义为温度高于 TH 或低于 TL。只要 DS1820 不掉电，报警状态将一直保持，直到再一次测得的温度值达不到报警条件。

#### I/O 信号

DS1820 需要严格的协议以确保数据的完整性。协议包括几种单线信号类型：复位脉冲、存在脉冲、写 0、写 1、读 0 和读 1。所有这些信号，除存在脉冲外，都是由总线控制器发出的。

和 DS1820 间的任何通讯都需要以初始化序列开始，初始化序列见图 11。一个复位脉冲跟着一个存在脉冲表明 DS1820 已经准备好发送和接收数据（适当的 ROM 命令和存储器操作命令）。

初始化过程“复位和存在脉冲”（图11）



DS1820 命令设置（表 2）

命令	说明	协议	单线总线发出协议后	备注
温度转换命令				
Convert T	开始温度转换	44h	<读温度忙状态>	1
存储器命令				
Read Scratchpad	读取暂存器和 CRC 字节	BEh	<读数据直到 9 字节>	
Write Scratchpad	把字节写入暂存器的地址 2 和 3（TH 和 TL 温度报警触发）	4Eh	<写两个的字节到地址 2 和 3>	
Copy Scratchpad	把暂存器内容拷贝到非易失性存储器中（仅指地址 2 和 3）	48h	<读拷贝状态>	2
Recall E <sup>2</sup>	把非易失性存储器中的值召回暂存器（温度报警触发）	B8h	<读温度忙状态>	
Read Power Supply	标识 DS1820 的供电模式	B4h	<读供电状态>	

备注：

1、温度转换时间可长达 500ms。接到温度转换的协议后，如果器件不是从 VDD 供电的话，I/O 线就必须至少保持 500ms 高电平。这样，发出一个 Convert T 命令之后，单线总线上在这段时间内就不能有其他活动。

2、接到 Copy Scratchpad 协议后，如果器件不是从 VDD 供电的话，I/O 线必须至少保持 10ms 高电平。这样，在发出一个 Copy Scratchpad 命令后，这段时间内单线总线上就不能有其他活动。

总线控制器发出（TX）一个复位脉冲（一个最少保持 480 μs 的低电平信号），然后释放总线，进入接收状态（RX）。单线总线由 5K 上拉电阻拉到高电平。探测到 I/O 引脚上的上升沿后，DS1820 等待 15~60 μs，然后发出存在脉冲（一个 60~240 μs 的低电平信号）。

存储器操作命令

下述命令协议概括于表 2，并用流程图示于图 10。

Write Scratchpad [4E]

这个命令向 DS1820 的暂存器中写入数据，开始位置在地址 2。接下来写入的两个字节将被存到暂存器中的地址位置 2 和 3。可以在任何时刻发出复位命令来中止写入。

Read Scratchpad [BEh]

这个命令读取暂存器的内容。读取将从字节 0 开始，一直进行下去，直到第 9（字节 8，CRC）

字节读完。如果不想读完所有字节，控制器可以在任何时间发出复位命令来中止读取。

#### Copy Scratchpad [48h]

这条命令把暂存器的内容拷贝到 DS18B20 的 E<sup>2</sup> 存储器里，即把温度报警触发字节存入非易失性存储器里。如果总线控制器在这条命令之后跟着发出读时间隙，而 DS18B20 又正在忙于把暂存器拷贝到 E<sup>2</sup> 存储器，DS18B20 就会输出一个“0”，如果拷贝结束的话，DS18B20 则输出“1”。如果使用寄生电源，总线控制器必须在这条命令发出后立即启动强上拉并最少保持 10ms。

#### Convert T [44h]

这条命令启动一次温度转换而无需其他数据。温度转换命令被执行，而后 DS18B20 保持等待状态。如果总线控制器在这条命令之后跟着发出读时间隙，而 DS18B20 又忙于做时间转换的话，DS18B20 将在总线上输出“0”，若温度转换完成，则输出“1”。如果使用寄生电源，总线控制器必须在发出这条命令后立即启动强上拉，并保持 500ms。

#### Recall E<sup>2</sup> [B8h]

这条命令把报警触发器里的值拷回暂存器。这种拷回操作在 DS18B20 上电时自动执行，这样器件一上电暂存器里马上就存在有效的数据了。若在这条命令发出之后发出读时间隙，器件会输出温度转换忙的标识：“0”=忙，“1”=完成。

#### Read Power Supply [B4h]

若把这条命令发给 DS18B20 后发出读时间隙，器件会返回它的电源模式：“0”=寄生电源，“1”=外部电源。

#### 读/写时间隙

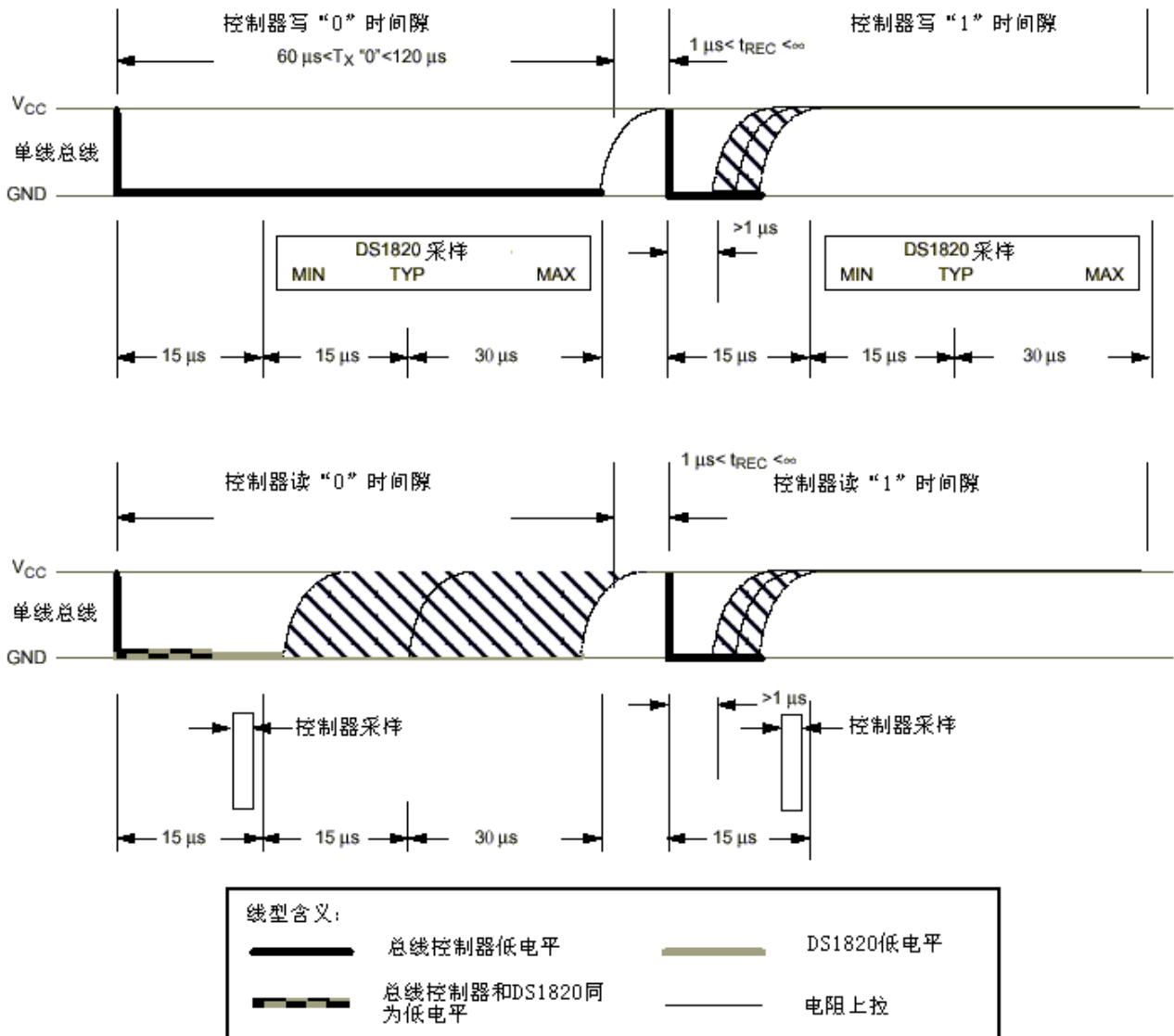
DS18B20 的数据读写是通过时间隙处理位和命令字来确认信息交换。

#### 写时间隙

当主机把数据线从逻辑高电平拉到逻辑低电平的时候，写时间隙开始。有两种写时间隙：写 1 时间隙和写 0 时间隙。所有写时间隙必须最少持续 60 μs，包括两个写周期间至少 1 μs 的恢复时间。

I/O 线电平变低后，DS18B20 在一个 15 μs 到 60 μs 的窗口内对 I/O 线采样。如果线上是高电平，就是写 1，如果线上是低电平，就是写 0（见图 12）

读/写时序图 (图12)



主机要生成一个写时间隙，必须把数据线拉到低电平然后释放，在写时间隙开始后的  $15\mu s$  内允许数据线拉到高电平。

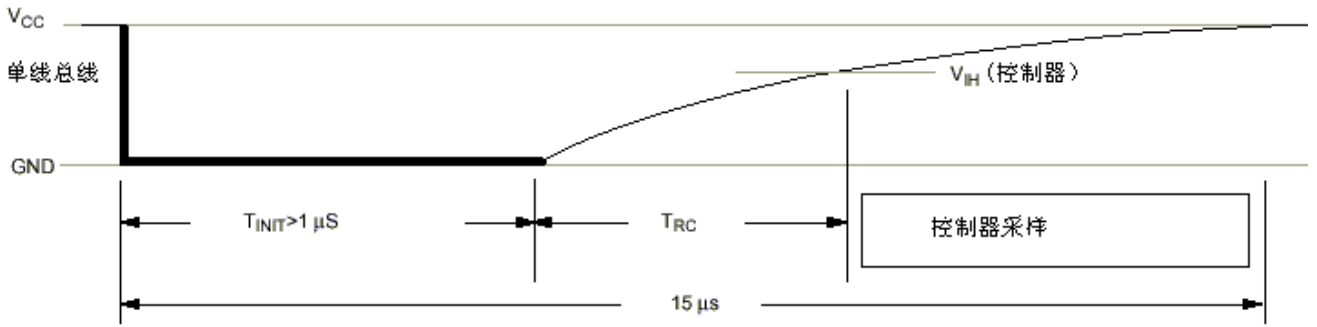
主机要生成一个写 0 时间隙，必须把数据线拉到低电平并保持  $60\mu s$ 。

读时间隙

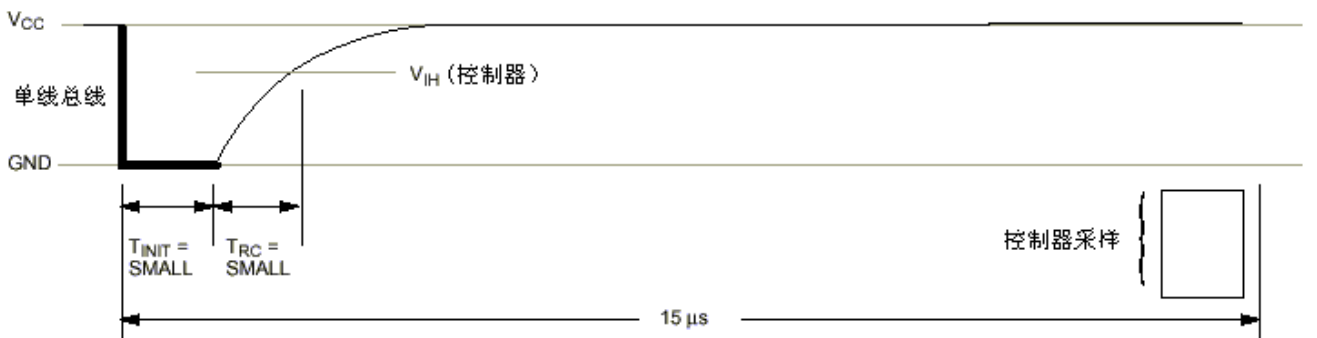
当从 DS18B20 读取数据时，主机生成读时间隙。当主机把数据线从高高平拉到低电平时，写时间隙开始。数据线必须保持至少  $1\mu s$ ；从 DS18B20 输出的数据在读时间隙的下降沿出现后  $15\mu s$  内有效。因此，主机在读时间隙开始后必须停止把 I/O 脚驱动为低电平  $15\mu s$ ，以读取 I/O 脚状态（见图 12）。在读时间隙的结尾，I/O 引脚将被外部上拉电阻拉到高电平。所有读时间隙必须最少  $60\mu s$ ，包括两个读周期期间至少  $1\mu s$  的恢复时间。

图 13 表示  $T_{INIT}$ 、 $T_{RC}$  和  $T_{SAMPLE}$  之和必须小于  $15\mu s$ 。图 14 示出，系统时间可以用下面方法达到最大： $T_{INIT}$  和  $T_{RC}$  保持时间尽可能小；把控制器采样时间放到  $15\mu s$  周期的最后。

控制器读“1”的详细时序(图13)



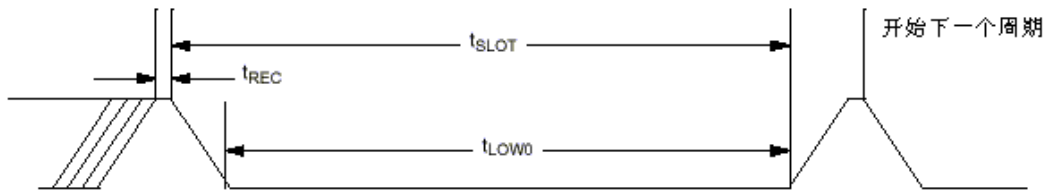
推荐控制器读“1”时序(图14)



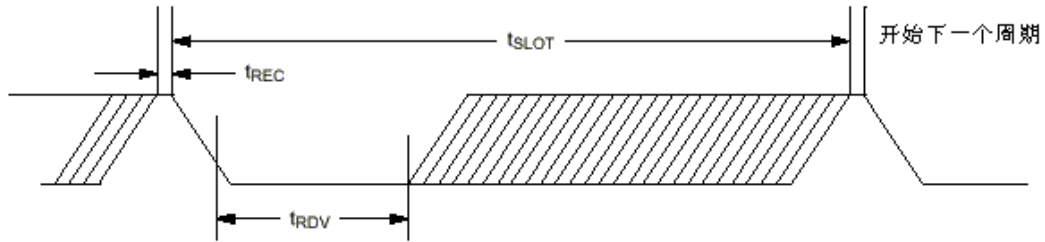
线型含义:	
	总线控制器低电平
	总线控制器和DS1820同为低电平
	DS1820低电平
	电阻上拉

伟纳电子

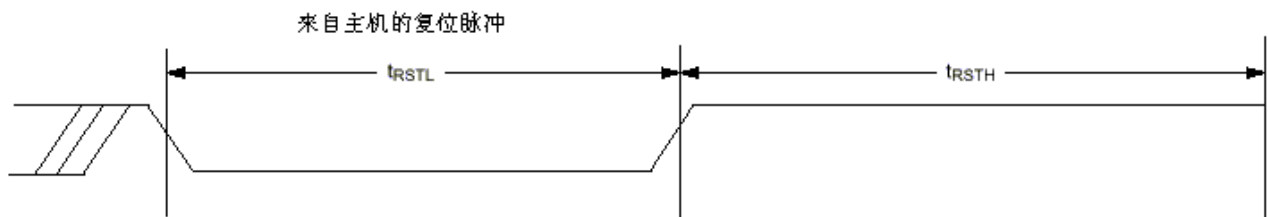
单线写0时间隙



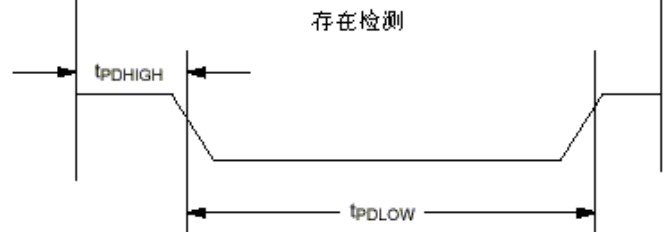
单线读0时间隙



单线复位脉冲

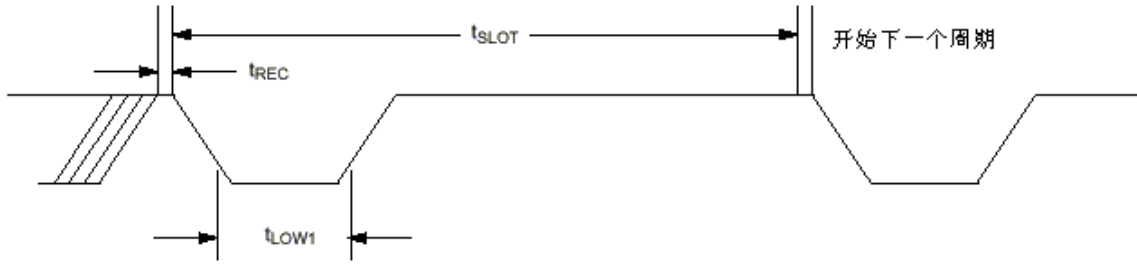


单线存在检测

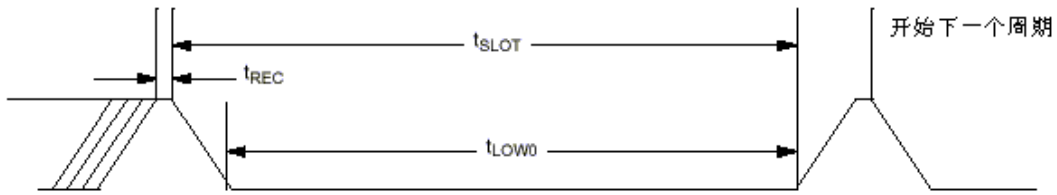


伟纳电子

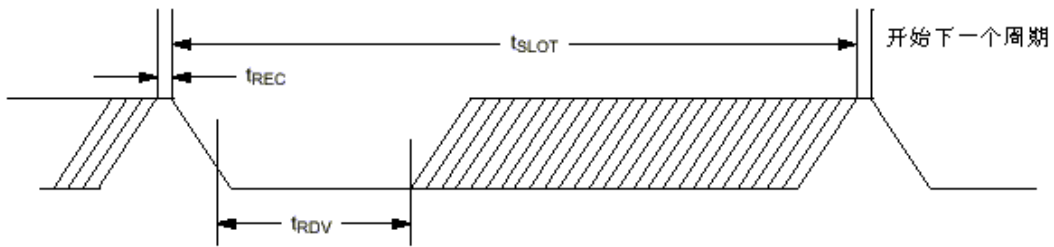
单线写1时间隙



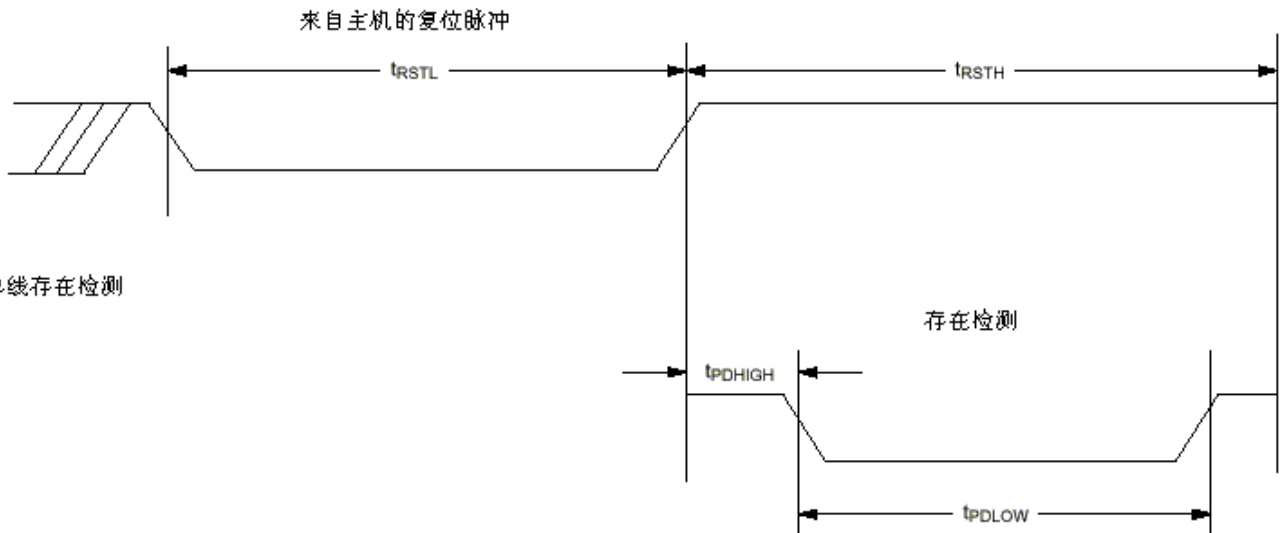
单线写0时间隙



单线读0时间隙



单线复位脉冲



存储器操作举例 (表 3)

例: 总线控制器启动温度转换, 然后读取温度 (寄生电源)

控制器状态	数据 (LSB 在前)	内容
TX	复位	复位脉冲 (480-960 μs)

RX	存在	存在脉冲
TX	55h	发“Match ROM”命令
TX	<64 位 ROM 编码>	发 DS1820 地址
TX	44h	发“Convert T”命令
TX	<I/O 线高电平>	I/O 线保持至少 500ms 高电平，以完成温度转换
TX	复位	复位脉冲
RX	存在	存在脉冲
TX	55h	发“Match ROM”命令
TX	<64 位 ROM 编码>	发 DS1820 地址
TX	BEh	发“Read Scratchpad”命令
RX	<9 个数据字节>	读整个暂存器加上 CRC；控制器重新计算从暂存读到的 8 个数据字节的 CRC，把计算的 CRC 和读取的 CRC 进行比较，如果相同，控制器向下进行，如果不同，就重复读操作。
TX	复位	复位脉冲
RX	存在	存在脉冲，结束。

#### 存储器操作举例（表 4）

例：总线控制器写存储器（寄生电源且只有一只 DS1820）

控制器状态	数据（LSB 在前）	内容
TX	复位	复位脉冲
RX	存在	存在脉冲
TX	CCh	Skip ROM 命令
TX	4Eh	Write Scratchpad 命令
TX	<两个数据字节>	写两个字节到暂存器（TH 和 TL）
TX	复位	复位脉冲
RX	存在	存在脉冲
TX	CCh	Skip ROM 命令
TX	BEh	Read Scratchpad 命令
RX	<9 个数据字节>	读整个暂存器加上 CRC；控制器重新计算从暂存读到的 8 个数据字节的 CRC，把计算的 CRC 和读取的 CRC 进行比较，如果相同，控制器向下进行，如果不同，就重复读操作。
TX	复位	复位脉冲
RX	存在	存在脉冲
TX	CCh	Skip ROM 命令
TX	48h	Copy Scratchpad 命令；发出这条命令后，控制器必须等待 6ms 到拷贝操作完成。
TX	复位	复位脉冲



RX	存在	存在脉冲，完成。
----	----	----------

### 存储器操作举例（表 5）

例：温度转换和插补（外部电源供电且只有一只 DS18B20）

控制器状态	数据 (LSB 在前)	内容
TX	复位	复位脉冲
TR	存在	存在脉冲
TX	CCh	Skip ROM 命令
TX	44h	Convert T 命令
RX	<1 个字节的数据>	读 8 次忙标志。控制器一字节（或位）接一个字节读下去，直到数据为 FFh（所有位都为 1）
TX	复位	复位脉冲
RX	存在	存在脉冲
TX	CCh	Skip ROM 命令
TX	BEh	Read Scratchpad 命令
RX	<9 个数据字节>	读整个暂存器加上 CRC；控制器重新计算从暂存读到的 8 个数据字节的 CRC，把计算的 CRC 和读取的 CRC 进行比较，如果相同，数据就是有效的。控制器存储温度值并分别存储计数寄存器的内容和每度计数值寄存器的内容，做为 COUNT_REMAIN 和 COUNT_PER_C。
TX	复位	复位脉冲
RX	存在	存在脉冲
——	——	CPU 按手册中的方法计算温度值以得到更高的分辨力。

极限使用条件：

各引脚对地电压：-0.5 到+7.0V

工作温度：-55 到+125℃

储存温度：-55 到+125℃

焊接温度：260℃10 秒

### 推荐直流工作条件

参数	符号	条件	最小	典型	最大	单位	备注
电源电压	VDD	I/O 操作 ±1/2℃温度转换 精度	2.8 4.3	5.0	5.5 5.5	V	1, 2
数据引脚	I/O		-0.5		+5.5	V	2
逻辑 1	V <sub>ih</sub>		2.0		VCC+0.3	V	2, 3
逻辑 0	V <sub>il</sub>		-0.3		+0.8	V	2, 4

### 直流电特性

参数	符号	条件	最小	典型	最大	单位	备注
----	----	----	----	----	----	----	----

温度误差	$t_{ERR}$	-0°C到+70°C -55°C到0°C 和+70°C到+125°C		$\pm 1/2$ 见曲线图		°C	1, 9, 10
输入逻辑高电平	$V_{IH}$		2.2		5.5	V	2, 3
输入逻辑低电平	$V_{IL}$		-0.3		+0.8	V	2, 4
吸收电流	$I_L$	$V_{I/O}=0.4V$	-4.0			mA	2
待机电流	$I_Q$			200	350	nA	8
动态电流	$I_{DD}$			1	1.5	mA	5, 6
输入负载电流	$I_L$			5		$\mu A$	7

**交流电特性:** (-55°C到+125°C; VDD=3.6V到5.5V)

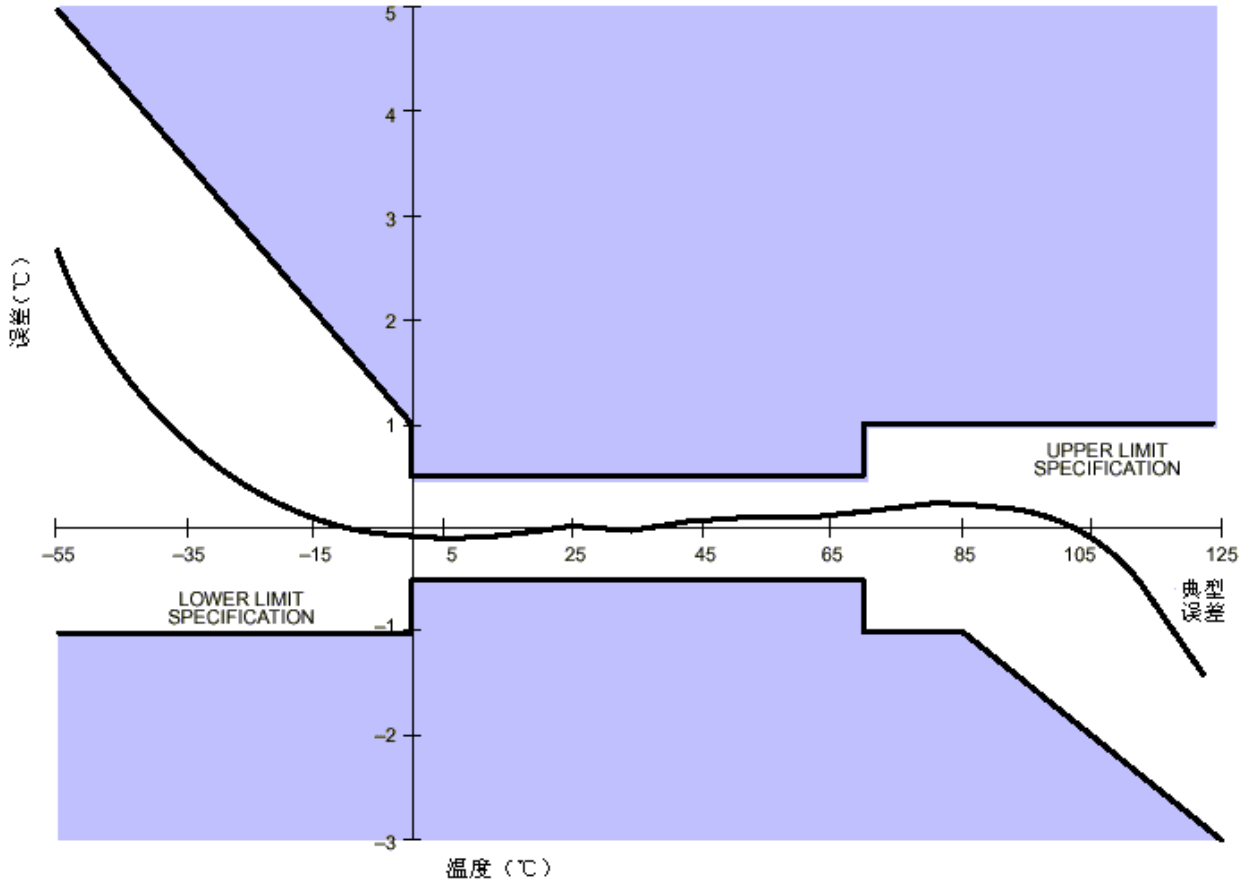
参数	符号	最小	典型	最大	单位	备注
温度转换时间	$t_{CONV}$		200	500	ms	
时间隙	$t_{SLOT}$	60		120	$\mu s$	
恢复时间	$t_{REC}$	1			$\mu s$	
写0低电平时间	$t_{LOW0}$	60		120	$\mu s$	
写1低电平时间	$t_{LOW1}$	1		15	$\mu s$	
读数据有效时间	$t_{RDV}$			15	$\mu s$	
复位高电平时间	$t_{RSTH}$	480			$\mu s$	
复位低电平时间	$t_{RSTL}$	480		4800	$\mu s$	
存在检测高电平时间	$t_{PDHIGHL}$	15		60	$\mu s$	
存在检测低电平时间	$t_{PDLLOW}$	60		240	$\mu s$	
电容	$C_{IN/OUT}$			25	pF	

备注:

- 1、VDD 低至 3.4V 时，温度转换精度  $\pm 2^\circ C$ 。
- 2、所有电压参考点都是接地点。
- 3、逻辑 1 电压在源电流为 1mA 时得到。
- 4、逻辑 0 电压在吸收电流为 4mA 时得到。
- 5、 $I_{DD}$  在 VCC 为 5.0V 时得到。
- 6、动态电流涉及温度转换和写 E<sup>2</sup> 存储器。写 E<sup>2</sup> 存储器最大用 10ms，消耗将近 100  $\mu A$  电流。
- 7、输入负载接地。
- 8、待机电流最大定义到 70°C。125°C 时典型待机电流为 5  $\mu A$ 。
- 9、见典型曲线图中超出 0°C 到 70°C 的部分。温度误差反映了传感器在校准时测试的精度。
- 10、典型精度曲线在 4.3V  $\leq$  VDD  $\leq$  5.5V 时有效。

典型工作曲线

DS18B20读数误差



伟纳电子